

ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

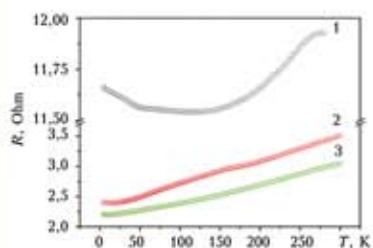


Fig. 1. Temperature dependence of the resistance of deformed InSb samples with different the concentration of charge carriers in the vicinity of the metal dielectric transition (in cm^{-3}):
1 – $6 \cdot 10^{16}$; 2 – $2 \cdot 10^{17}$; 3 – $6 \cdot 10^{17}$

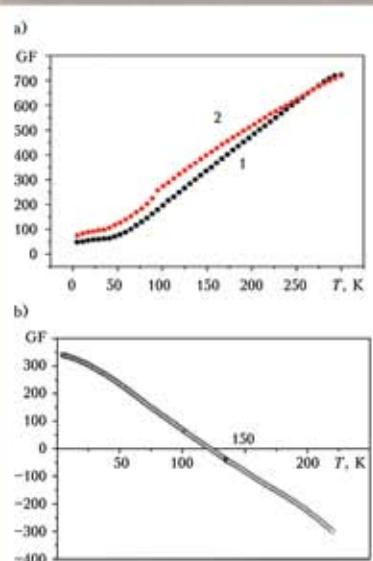


Fig. 2. Temperature dependence of the gauge factor for InSb microcrystals with different the concentration of charge carriers (in cm^{-3}):
a) 1 – $2 \cdot 10^{17}$; 2 – $6 \cdot 10^{17}$; b) $6 \cdot 10^{16}$

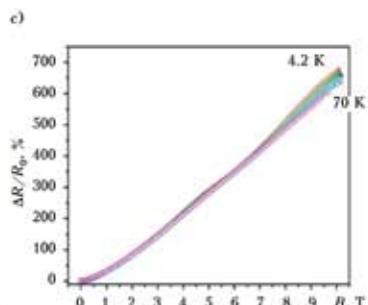
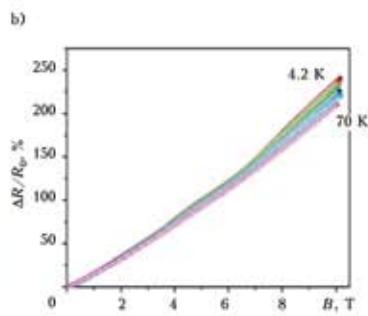
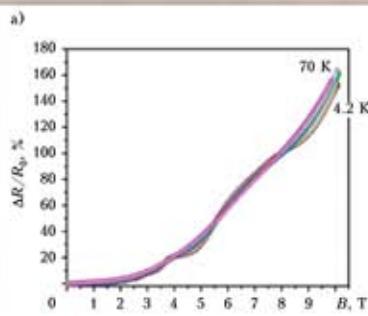


Fig. 3. Transversal magnetoresistance of InSb whiskers with different tin concentration (in cm^{-3}) for strained samples at temperature range 4.2–70 K:
a – $6 \cdot 10^{16}$; b – $6 \cdot 10^{17}$; c – $2 \cdot 10^{17}$

До статті
«Deformation-induced effects in indium antimonide microstructures at cryogenic temperatures for sensor applications»

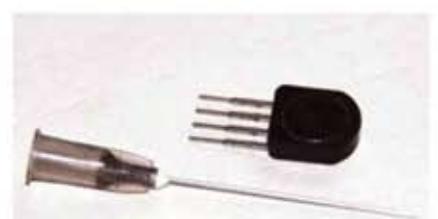


Fig. 4. Typical view of sensors of physical quantities

3–4 2019

МАЙ — АВГУСТ

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»**

ISSN 2225-5818

Выходит один раз в 2 месяца

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К. т. н. А. Ф. Бондаренко

(КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Акад. НАНУ, г. ф.-м. н. А. Е. Беляев (г. Киев, Украина)

Д. т. н. Н. М. Вакив (г. Львов, Украина)

Д. т. н. Г. А. Оборский (г. Одесса, Украина)

К. т. н. В. М. Чмиль В. (г. Киев, Украина)

Е. А. Тихонова (г. Одесса, Украина)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д. т. н. С. Г. Антощук (г. Одесса, Украина)

Д. т. н. А. П. Бондарев (г. Львов, Украина)

Prof. I. Vajda (Budapest, Hungary)

Prof. D. Vinnikov (Tallinn, Estonia)

Prof. I. Galkin (Riga, Latvia)

К. т. н. Э. Н. Глущенко (г. Киев, Украина),
зам. главного редактора

К. т. н. Г. Г. Горох (г. Минск, Республика Беларусь)

Prof. K. Dhoska (Tirana, Albania)

Д. ф.-м. н. В. В. Должиков (г. Харьков, Украина)

Д. т. н. А. А. Дружинин (г. Львов, Украина)

Д. т. н. А. А. Ефименко (г. Одесса, Украина),
зам. главного редактора

Д. ф.-м. н. Д. В. Корбутяк (г. Киев, Украина)

Д. т. н. С. И. Круковский (г. Львов, Украина)

Чл.-кор. НАНУ, г. ф.-м. н. В. С. Лысенко (г. Киев,
Украина)

Prof. J. Martins (Caparica, Portugal)

Д. т. н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков, Украина)

Dr. Sc. D. Nika (Chisinau, Moldova)

Д. т. н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев, Украина)

Prof. V. Pires (Setúbal, Portugal)

Д. ф.-м. н. С. В. Плаксин (г. Днепропетровск,
Украина)

К. т. н. Прокопец В. М. (г. Киев, Украина)

Prof. E. Romero-Cadaval (Badajoz, Spain)

К. ф.-м. н. А. В. Рыбка (г. Харьков, Украина)

К. т. н. П. С. Сафонов (г. Одесса, Украина),
отв. секретарь редколлегии

Д. т. н. В. Н. Сидорец (г. Киев, Украина)

Д. т. н. В. С. Ситников (г. Одесса, Украина)

Dr. Sc. Z. Stević (Belgrade, Serbia)

Д. х. н. В. Н. Томашек (г. Киев, Украина)

К. т. н. В. Е. Трофимов (г. Одесса, Украина)

Подписка на журнал

Отделения связи. «Каталог видань України». Индекс 23785.

В редакции «ТКЭА» можно подписаться с любого номера.

Контактная информация

Украина, 65044, г. Одесса, а/я 17;

tkea.journal@gmail.com, www.tkea.com.ua,

+38 099 444 63 52.

Редакция

*Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко, П. С. Сафонов,
А. А. Алексеева, М. Г. Глава, Н. М. Колганова, Е. И. Корецкая.*

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

Зарегистрирован
в ВАК Украины
по разделам
«Физико-математические науки»,
«Технические науки»

Реферируется
в УРЖ «Джерело»
(г. Киев)

Журнал включен
в международную справочную
систему по периодическим
и продолжающимся изданиям
“Ulrich's Periodicals Directory”
(США),
в международную систему
библиографических ссылок
CrossRef,
в научометрическую базу РИНЦ,
в базу данных DOAJ,
в Google Scholar

Номер выпущен при поддержке
ОНПУ (г. Одесса),
НПП «Сатурн» (г. Киев),
НПП «Карат» (г. Львов)

Одобрено к печати
Ученым советом ОНПУ
(Протокол № 2 от 24.09 2019 г.)
Отв. за выпуск: Е. А. Тихонова

УЧРЕДИТЕЛИ
Институт физики полупровод-
ников им. В. Е. Лашкарёва
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство «Политехпериодика»

Свидетельство о регистрации
№ КВ 21788-11688ПР
от 21.12.2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2019 № 3–4

Год издания 43-й

СОДЕРЖАНИЕ

Новые компоненты для электронной аппаратуры

Деформационно-стимулированные эффекты в микроструктурах антимонида индия при криогенных температурах для сенсорных применений. А. А. Дружинин, Ю. Н. Ховерко, И. П. Островский, Н. С. Лях-Кагуй, Е. А. Пасынкова (на английском) 3

Электронные средства: исследования, разработки

Уменьшение шумов и помех путем рационального выбора электронных компонентов в каналах с сосредоточенными параметрами при высокоскоростной обработке данных. А. Н. Тыныныка 10

Энергетическая электроника

Изменения характеристик кремниевых фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей после токовых перегрузок. А. В. Иванченко, А. С. Тонкошкур 19

Сенсоэлектроника

Высокотемпературные датчики деформации на основе нитевидных кристаллов фосфида галлия. А. О. Дружинин, И. И. Марьямова, А. П. Кутраков (на украинском) 26

Метрология. Стандартизация

Поверхностные слои ZnSe:Ca с дырочной проводимостью. В. П. Махний, М. М. Березовский, О. В. Кинзерская, В. В. Мельник (на английском) 31

Материалы электроники

Высокоинформационный комплексный метод определения типа моторного масла. А. В. Мамыкин, А. Л. Кукла, Л. М. Матвиенко, А. В. Дорожинская, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинский 36

Рецензенты номера

Новые книги 25, 30

ЗМІСТ

CONTENTS

Нові компоненти для електронної апаратури

Деформаційно-стимульовані ефекти в мікроструктурах антимоніду індію за кріогенних температур для сенсорних застосувань. *A. O. Дружинін, Ю. М. Ховерко, І. П. Острозвський, Н. С. Лях-Кагуй, О. А. Пасинкова* (3)

Електронні засоби: дослідження, розробки

Зменшення шумів і завад шляхом раціонального вибору електронних компонентів в каналах з зосередженими параметрами при високочастотній обробці даних. *О. М. Тинника* (10)

Енергетична електроніка

Зміни характеристик кремнієвих фотовоелектрических перетворювачів сонячних батарей після струмових перевантажень. *О. В. Іванченко, О. С. Тонкошкур* (19)

Сенсоелектроніка

Високотемпературні сенсори деформації на основі ниткоподібних кристалів фосфіду галію. *А. О. Дружинін, І. Й. Мар'ямова, О. П. Кутраков* (26)

Матеріали електроніки

Поверхневі шари ZnSe:Ca з дірковою провідністю. *В. П. Махній, М. М. Березовський, О. В. Кінзерська, В. В. Мельник* (31)

Метрологія. Стандартизація

Високоінформативний комплексний метод визначення типу моторного масла. *А. В. Мамікін, О. Л. Кукла, Л. М. Матвієнко, Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинський* (36)

New components for electronic equipment

Deformation-induced effects in indium antimonide microstructures at cryogenic temperatures for sensor applications *A. O. Druzhinin, Yu. M. Khoverko, I. P. Ostrovskii, N. S. Liakh-Kaguy, O. A. Pasynkova* (3)

Electronic devices: research, development

Reduction of noise and interference by rational selection of electronic components in lumped parameter channels at high speed data processing. *A. N. Tupyntya* (10)

Power electronics

Changes in the characteristics of silicon photovoltaic cells of solar arrays after current overloads. *A. V. Ivanchenko, A. S. Tonkoshkur* (19)

Sensors

High temperature strain sensors based on gallium phosphide whiskers. *A. O. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov* (26)

Materials of electronics

Surface ZnSe:Ca layers with hole conductivity. *V. P. Makhniy, M. M. Berezovskiy, O. V. Kinzerska, V. V. Melnyk* (31)

Metrology, standardization

Highly informative integrated method for determining the type of engine oil. *A. V. Mamykin, A. L. Kukla, L. M. Matvienko, H. V. Dorozinska, V. P. Maslov, G. V. Dorozinsky* (36)